

	<h2 style="color: #E67E22;">FQU13N06LTU-WS</h2>
 <p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	Hersteller-Teilenummer: FQU13N06LTU-WS
	Hersteller / Marke: AMI Semiconductor / ON Semiconductor
	Teil der Beschreibung: MOSFET N-CH 60V 11A IPAK
	Datenblätter:  FQU13N06LTU-WS.pdf
	RoHS Status: Bleifrei / RoHS-konform
	Lagerzustand: New original, Stock Available.
	Liefern von: Hong Kong
Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS	

Spezifikationen

Teilenummer	FQU13N06LTU-WS
Hersteller	AMI Semiconductor / ON Semiconductor
Beschreibung	MOSFET N-CH 60V 11A IPAK
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs,
Teilstatus	Require For Quote & Check Stock
VGS (th) (Max) @ Id	2.5V @ 250µA
Vgs (Max)	±20V
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Supplier Device-Gehäuse	I-PAK
Serie	QFET®
Rds On (Max) @ Id, Vgs	115 mOhm @ 5.5A, 10V
Verlustleistung (max)	2.5W (Ta), 28W (Tc)
Verpackung	Tube
Verpackung / Gehäuse	TO-251-3 Short Leads, IPak, TO-251AA
Andere Namen	FQU13N06LTU_WS
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Through Hole
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	1 (Unlimited)
Hersteller Standard Vorlaufzeit	4 Weeks
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	350pF @ 25V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	6.4nC @ 5V
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	5V, 10V
Drain-Source-Spannung (Vdss)	60V
detaillierte Beschreibung	N-Channel 60V 11A (Tc) 2.5W (Ta), 28W (Tc) Through
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	11A (Tc)

FQU13N06LTU-WS Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, FQU13N06LTU-WS-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, FQU13N06LTU-WS AMI Semiconductor / ON Semiconductor mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.
RFQ FQU13N06LTU-WS E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p>FQU13N06LTU_WS Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 60V 11A IPAK</p>	 <p>FQU13N06LTU Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 60V 11A IPAK</p>	 <p>FQU13N06L @@@@ FAIRC FQU13N06L @@@@ FAIRC</p>	 <p>FQU13N06 @@@@ FAIRC FQU13N06 @@@@ FAIRC</p>
 <p>FQU13N06L FAIRCHI FQU13N06L FAIRCHI</p>	 <p>FQU13N06TU AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 60V 10A IPAK</p>	 <p>FQU13N10 @@@@ FAIRC FQU13N10 @@@@ FAIRC</p>	 <p>FQU13N06LTU AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 60V 11A IPAK</p>

Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

FQU13N06LTU-WS AMI Semiconductor / ON Semiconductor	FQU13N06LTU-WS Datenblatt	FQU13N06LTU-WS-Datenblätter	FQU13N06LTU-WS PDF	AMI Semiconductor / ON Semiconductor FQU13N06LTU-WS
FQU13N06LTU-WS Electronic	FQU13N06LTU-WS-Komponenten	FQU13N06LTU-WS-Verteiler	FQU13N06LTU-WS-Bild	FQU13N06LTU-WS-Teil
FQU13N06LTU-WS Preis	FQU13N06LTU-WS Hersteller	FQU13N06LTU-WS Bild	FQU13N06LTU-WS Aktie	FQU13N06LTU-WS Inventar
FQU13N06LTU-WS Neu	FQU13N06LTU-WS Original	FQU13N06LTU-WS garantiert	FQU13N06LTU-WS RFQ	FQU13N06LTU-WS Online bestellen

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited